

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載

【部門区分】第7部門第2区分

【発行日】平成25年11月14日(2013.11.14)

【公開番号】特開2012-138500(P2012-138500A)

【公開日】平成24年7月19日(2012.7.19)

【年通号数】公開・登録公報2012-028

【出願番号】特願2010-290565(P2010-290565)

【国際特許分類】

|        |        |           |
|--------|--------|-----------|
| H 01 L | 21/316 | (2006.01) |
| H 01 L | 21/768 | (2006.01) |
| H 01 L | 23/532 | (2006.01) |
| H 01 L | 21/336 | (2006.01) |
| H 01 L | 29/78  | (2006.01) |
| H 01 L | 21/28  | (2006.01) |
| H 01 L | 29/423 | (2006.01) |
| H 01 L | 29/49  | (2006.01) |

【F I】

|        |        |         |
|--------|--------|---------|
| H 01 L | 21/316 | X       |
| H 01 L | 21/90  | P       |
| H 01 L | 21/90  | K       |
| H 01 L | 29/78  | 3 0 1 G |
| H 01 L | 21/316 | M       |
| H 01 L | 21/28  | B       |
| H 01 L | 21/28  | 3 0 1 R |
| H 01 L | 29/58  | G       |

【手続補正書】

【提出日】平成25年10月2日(2013.10.2)

【手続補正1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】請求項1

【補正方法】変更

【補正の内容】

【請求項1】

(1) 被処理体上にタングステン膜又は酸化タングステン膜を形成し、  
 (2) 前記被処理体を加熱し、前記加熱された前記被処理体に、アミノシラン系ガスを供給し、  
 (3) 前記アミノシラン系ガスが供給された前記被処理体に、シリコンを含むシリコン原料ガスと、酸化剤を含むガスとを交互に供給し、前記タングステン膜又は酸化タングステン膜が形成された前記被処理体上に、酸化シリコン膜を形成することを特徴とするタングステン膜又は酸化タングステン膜上への酸化シリコン膜の成膜方法。

【手続補正2】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0007

【補正方法】変更

【補正の内容】

【0007】

この発明の第1の態様に係るタングステン膜又は酸化タングステン膜上への酸化シリコン膜の成膜方法は、(1)被処理体上にタングステン膜又は酸化タングステン膜を形成し

、(2)前記被処理体を加熱し、前記加熱された前記被処理体に、アミノシラン系ガスを供給し、(3)前記アミノシラン系ガスが供給された前記被処理体に、シリコンを含むシリコン原料ガスと、酸化剤を含むガスとを交互に供給し、前記タンゲステン膜又は酸化タンゲステン膜が形成された前記被処理体上に、酸化シリコン膜を形成する。

【手続補正3】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0008

【補正方法】変更

【補正の内容】

【0008】

この発明の第2の態様に係る成膜装置は、タンゲステン膜又は酸化タンゲステン膜上への酸化シリコン膜を成膜する成膜装置であって、前記タンゲステン膜又は酸化タンゲステン膜が形成された被処理体を収容する処理室と、前記処理室内に、アミノシラン系ガス及びシリコン原料ガスの少なくとも一方、並びに酸化剤を含むガスを供給するガス供給機構と、前記処理室内を加熱する加熱装置と、前記処理室内を排気する排気装置と、前記ガス供給機構、前記加熱装置、前記排気装置を制御するコントローラと、を備え、前記コントローラが、前記処理室内において、上記第1の態様に係るタンゲステン膜又は酸化タンゲステン膜上への酸化シリコン膜の成膜方法が、前記被処理体に対して実行されるように、前記ガス供給機構、前記加熱装置、前記排気装置を制御する。